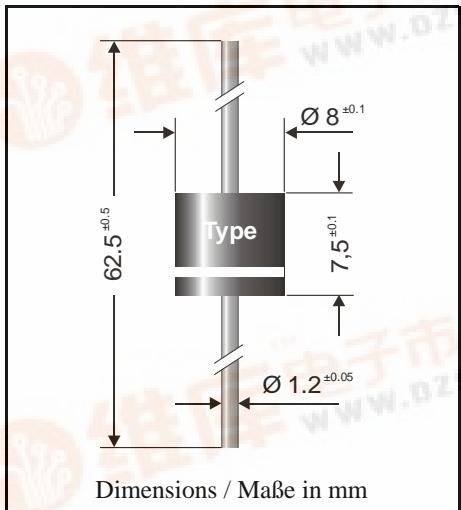


Fast Silicon Rectifiers**Schnelle Silizium Gleichrichter**

Version 2004-04-06



Nominal current – Nennstrom	12 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50V, 200 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	Ø 8 x 7.5 [mm] P-600 Style
Weight approx. – Gewicht ca.	1.5 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	

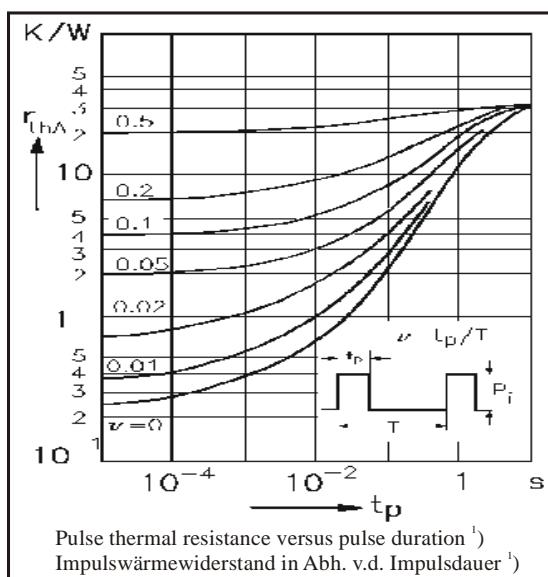
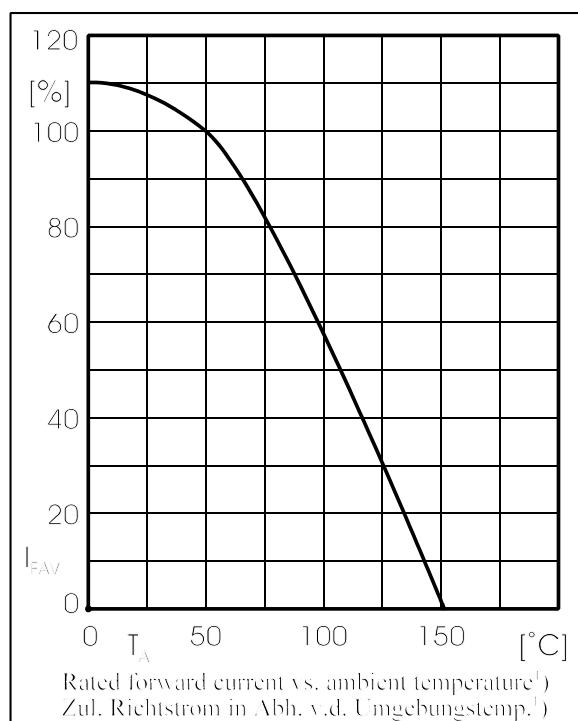
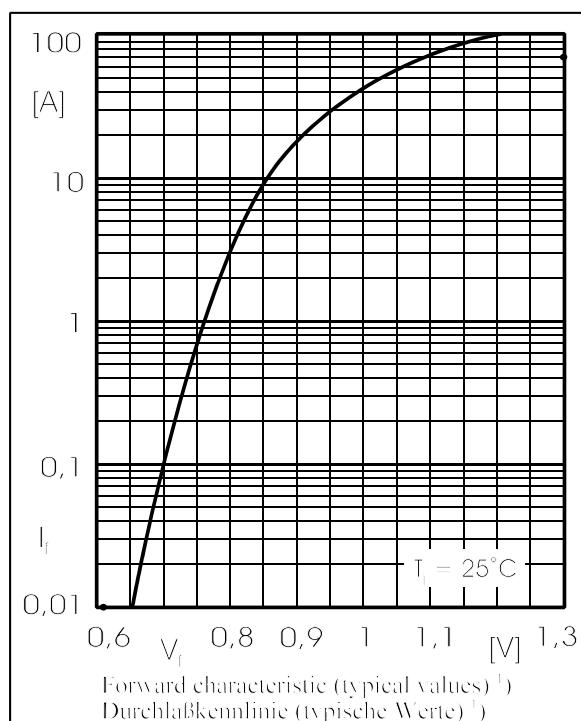
Maximum ratings**Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
F1200A	50	50
F1200D	200	200

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_A = 50^\circ C$	I_{FAV}	12 A ¹⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 \text{ Hz}$	I_{FRM}	80 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ C$	I_{FSM}	375 A
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ C$	I_{FSM}	390 A
Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$	$T_A = 25^\circ C$	i^2t	680 A ² s
Operating junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	$T_j = -50 \dots +150^\circ C$ $T_s = -50 \dots +175^\circ C$		

Characteristics
Kennwerte

Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 5 \text{ A}$	V_F	< 0.82 V
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 25 μA
Reverse recovery time Sperrverzug		$I_F = 0.5 \text{ A}$ through/über $I_R = 1 \text{ A}$ to/auf $I_R = 0.25 \text{ A}$	t_{rr}	< 200 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 10 K/W ¹⁾


¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden